

关键指标

频率: 2~6GHz
 功率增益: 25dB
 饱和输出功率: 31dBm
 功率效率: 33%
 电压/静态电流: VD:+8V/380mA, Vg:-0.68V
 芯片尺寸: 2.55mm×1.75mm

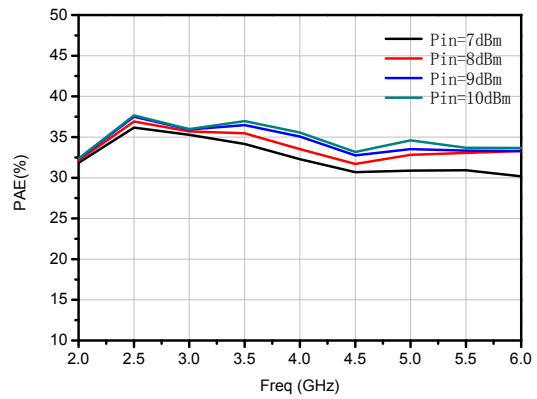
产品简介

HG134F3A 是一款工作在 2~6GHz 的宽带功率放大器芯片, 功率增益为 25dB, 输出功率为 31dBm, 采用双电源共电, 正电压为+8V, 静态电流为 380mA, 输入输出端均集成有隔直电容。

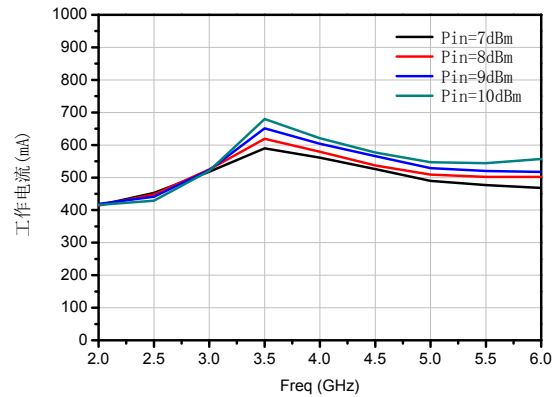
电性能 (TA=25°C, VD=+8V, Vg=-0.68V, Pin=8dBm)

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	2~6		
功率增益(dB)	-	25	-
增益平坦度(dB)	-	±1	-
输入驻波	-	1.6	-
输出功率(dBm)	-	31	-
功率附加效率 (%)	-	33	-
静态电流 (mA)	-	380	-

功率附加效率

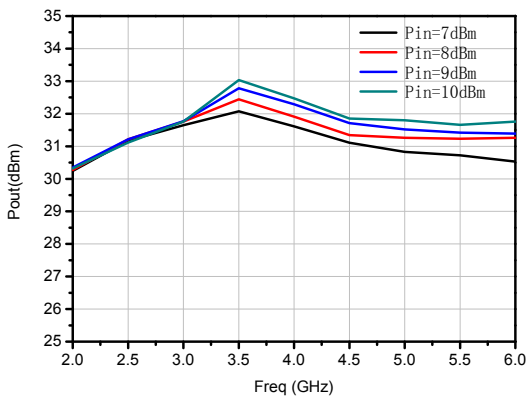


动态电流

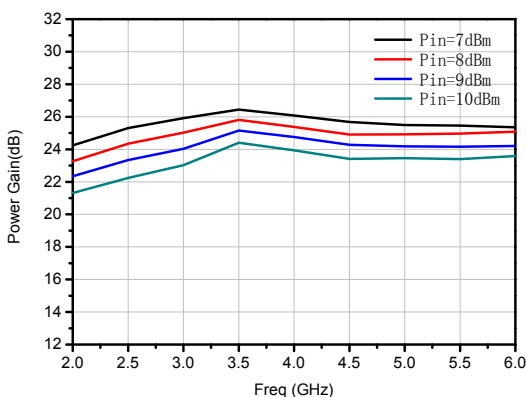


典型测试曲线

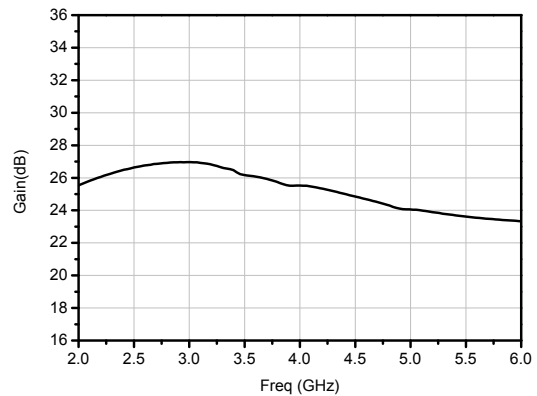
输出功率



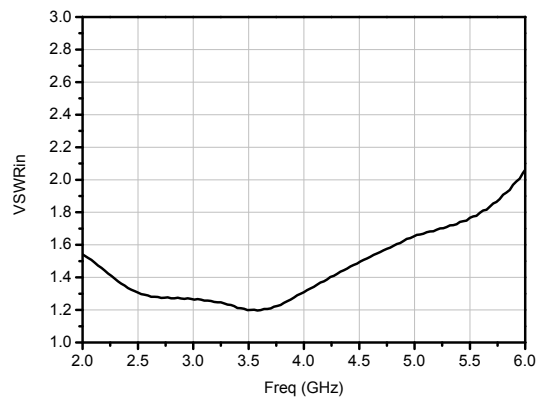
功率增益



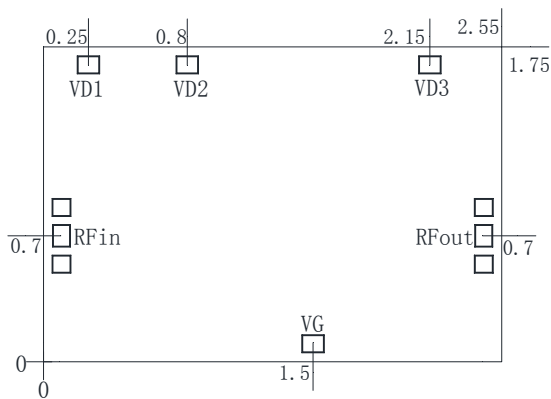
小信号增益



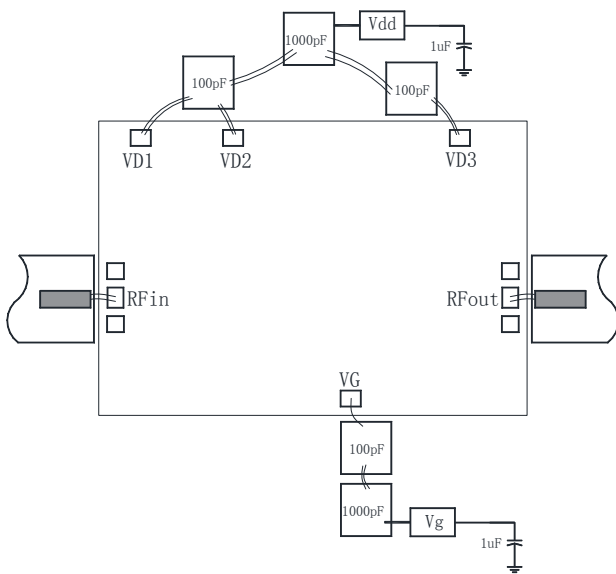
输入驻波



外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图



绝对额定最大值

工作电压	+10V
最大输入功率	+20dBm
工作温度	-55°C ~ 125°C
存储温度	-65°C ~ 150°C

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片采用金锡合金烧结（合金温度不能超过 300°C，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用Φ25μm 双金丝键合，建议金丝长度 250~400μm；
5. 芯片微波端有隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。